

Содержание

● Атомная структура и неэлектронные свойства полупроводников

Магомедов М.Н.

Параметры самодиффузии в кристаллах подгруппы углерода 289

Феклистов К.В., Федина Л.И., Черков А.Г.

Преципитация бора в Si при высокодозной имплантации . 302

● Электронные и оптические свойства полупроводников

Кязым-заде А.Г., Салманов В.М., Салманова А.А., Алиева А.М., Ибаева Р.З.

Фотопроводимость и люминесценция кристаллов GaSe при высоких уровнях оптического возбуждения 306

Ромака В.А., Fruchart D., Hill E.K., Гладышевский Р.Е., Gignoux D., Ромака В.В., Кужель Б.С., Крайовский Р.В.

Особенности интерметаллического полупроводника n -ZrNiSn, сильно легированного атомами редкоземельных металлов 310

Дмитриев А.И., Моргунов Р.Б., Казакова О.Л. (Kazakova O.L.)

Влияние отжига на микроволновое магнетосопротивление в тонких пленках $\text{Ge}_{0,96}\text{Mn}_{0,04}$ 320

● Полупроводниковые структуры, границы раздела и поверхность

Лисоченко В.Н., Конакова Р.В., Коноплев Б.Г., Кушнир В.В., Охрименко О.Б., Светличный А.М.

Уменьшение поглощения в структурах кварц/Si, кварц/Si/SiO₂ и SiC/Si/SiO₂ под влиянием лазерной обработки 326

Усмонов Ш.Н., Мирсагатов Ш.А., Лейдерман А.Ю.

Исследование вольт-амперной характеристики гетеро-структуры n -CdS/ p -CdTe в зависимости от температуры . 330

Ильчук Г.А., Кусьнэж В.В., Рудь В.Ю., Рудь Ю.В., Шаповал П.И., Петрусь Р.Ю.

Фоточувствительность гетеропереходов n -CdS/ p -CdTe, полученных химическим поверхностным осаждением CdS . 335

Мездрогина М.М., Даниловский Э.Ю., Кузьмин Р.В.

Сенсибилизация излучения и механизмы миграции электронных возбуждений в структурах на основе III-нитридов, легированных редкоземельными элементами (Eu, Er, Sm) 338

● Низкоразмерные системы

Новиков А.В., Яблонский А.Н., Платонов В.В., Оболенский С.В., Лобанов Д.Н., Красильник З.Ф.

Влияние радиационного воздействия на люминесцентные свойства низкоразмерных гетероструктур SiGe/Si(001) . 346

Кучерова О.В., Зубков В.И., Соломонов А.В., Давыдов Д.В.

Наблюдение локализованных центров с аномальным поведением в светоизлучающих гетероструктурах с множественными квантовыми ямами InGaN/GaN 352

Гуляев Д.В., Журавлев К.С.

Форма рельефа гетерограниц в (311)A-ориентированных структурах GaAs/AlAs 358

● Аморфные, стеклообразные, пористые, органические, микрокристаллические полупроводники, полупроводниковые композиты

Агафонова Е.А., Мартышов М.Н., Форш П.А., Тимошенко В.Ю., Кашкаров П.К.

Влияние термического окисления на перенос носителей заряда в наноструктурированном кремнии 367

Николаев Ю.А., Рудь В.Ю., Рудь Ю.В., Теруков Е.И., Геллер Н.М., Иванов А.Г., Шаманин В.В.

Гетеропереходы полисалицилиденазометины/Si (GaAs): создание и свойства 372

● Физика полупроводниковых приборов

Журавлева О.В., Иванов А.В., Курносков В.Д., Курносков К.В., Романцевич В.И., Чернов Р.В.

Оценка надежности полупроводникового излучателя ИЛПН-134 377

Анисимов О.В., Гаман В.И., Максимова Н.К., Найденов Ю.П., Новиков В.А., Севастьянов Е.Ю., Рудов Ф.В., Черников Е.В.

Влияние золота на свойства сенсоров диоксида азота на основе тонких пленок WO₃ 383

Закгейм А.Л., Курьшев Г.Л., Мизеров М.Н., Половинкин В.Г., Рожанский И.В., Черняков А.Е.

Исследование тепловых процессов в мощных InGaN/GaN флип-чип светодиодах с использованием инфракрасной тепловизионной микроскопии 390

Поклонский Н.А., Горбачук Н.И., Шпаковский С.В., Ластовский С.Б., Wiecek A.

Влияние радиационных дефектов на электрические потери в кремниевых диодах, облученных электронами 397

Кузнецов В.П., Кузнецов М.В., Красильник З.Ф.

Диодные структуры Si:Er/Si для наблюдения электролюминесценции на длине волны 1.5 мкм при 300 К 402

- **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Богатыренко В.В.

Метод измерения скорости поверхностной рекомбинации в кремниевых пластинах по их тепловому излучению . . . 409

Кузнецов В.П., Красильник З.Ф.

Метод сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии структур на основе кремния 413

Дроздов М.Н., Дроздов Ю.Н., Лобанов Д.Н., Новиков А.В., Юрасов Д.В.

Использование кластерных вторичных ионов Ge_2^- , Ge_3^- для повышения разрешения по глубине при послойном элементном анализе полупроводниковых гетероструктур GeSi/Si методом ВИМС 418

Садофьев Ю.Г., Samal N., Андреев Б.А., Гавриленко В.И., Морозов С.В., Спиваков А.Г., Яблонский А.Н.

Напряженные структуры GaAsSb/GaAs с квантовыми ямами для лазеров диапазона 1.3 мкм 422